

# テキサス・インスツルメンツ： 次世代を担う半導体製造施設を 米国テキサス州リチャードソンで建設

## 製造能力の拡大

- RFAB2 は、TI では 3 番目、そして自社最大の 300mm ウェハー・ファブになります。この施設が 初期の製造を開始しました
- RFAB2 は、2010 年に操業を開始した世界初の 300mm アナログ・ウェハー・ファブ、RFAB1 に隣接しています

## 高度な製造能力

- クリーン・ルームの面積を合計すると、58,000 平方メートルを上回る規模です
- 合計 24km を上回る長さに達している自動型の頭上運搬設備は、複数のファブ間でウェハーをシームレスに運搬します
- 実生産を開始する段階で、RFAB1 と RFAB2 は合計で 1 日あたり 1 億個を上回るアナログ・チップを製造する見通しであり、これらはあらゆる場所にあるエレクトロニクス機器で活用できます

## 持続可能な未来

- 責任ある、そして持続可能な製造に対する長期的な取り組み
- RFAB2 は、LEED Gold 基準に適合する設計を採用しています。RFAB1 は、世界で初めて LEED Gold 認証を取得したアナログ半導体製造施設です

## 強いコミュニティ

- テキサス州北部で 90 年以上にわたる実績
- 2010 年以降、テキサス州北部にある複数のコミュニティ (地方政府) で 数億ドルを投資してきました

